

財團法人工業技術研究院 函

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：林秀姿

電話：03-5916636

傳真：03-5820466

E-mail：iris.lin@itri.org.tw



107001989411

24159 新北市三重區重新路五段 609 巷 14 號 9 樓之 3

受文者：台灣區照明燈具輸出業同業公會(TLFEA)

發文日期：中華民國 107 年 11 月 07 日

發文字號：工研轉字第 1070019894 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：為本院「軟性電子、半導體光源及平面顯示器相關專利組合讓與案」公開招標活動，敬請轉知 貴會會員等相關廠商重要資訊，把握機會參與本活動，請 查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智財防護能力，本院將辦理軟性電子、半導體光源及平面顯示器相關專利 45 案 110 件之讓與公開招標活動(詳如附件)。

二、有關本活動詳細資訊，請參考下列網站公告：

(一) 工研院研發成果公告網站

<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>

(二) 台灣技術交易資訊網

<https://www.twtm.com.tw/Web/news/trans.aspx>

三、本案截標日為 107 年 12 月 4 日，開標日為 107 年 12 月 6 日。

四、公開說明會：

(一) 舉辦時間：民國(下同) 107 年 11 月 23 日下午 14 時至 15 時。

照明燈具公會
收文第 107429 號
107 年 11 月 8 日

(二) 舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。

(三) 報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 107 年 11 月 22 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（主旨上註明「軟性電子、半導體光源及平面顯示器相關專利組合讓與案公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）向本案聯絡人報名。聯絡人將於 107 年 11 月 22 日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、本案聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心 林小姐

電話：(03)591-6636

傳真：(03)582-0466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：台灣區照明燈具輸出業同業公會(TLFEA)

院長



依權責劃分規定授權業務主管決行



工業技術研究院

軟性電子、半導體光源及平面顯示器相關專利組合讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：本讓與案共計 7 組專利組合（以下簡稱「專利組合」），包含單音腔結構之揚聲器單元 6 案 14 件、多音腔結構之揚聲器單元 8 案 20 件、投射式電容觸控感應器 3 案 6 件、GaN on Si 基板技術 12 案 18 件、UV LED 磊晶與封裝 9 案 22 件、智慧照明技術 3 案 19 件、平面顯示器 4 案 11 件，合計共 45 案 110 件專利，以下合稱「讓與標的」，「讓與標的」中之平面顯示器 4 案 11 件係與第三人共有（以下簡稱「共有標的」），部分「讓與標的」為科專成果，部分屬工研院自有成果，詳細情形請參「附件：讓與標的清單」。「讓與標的」相關資訊詳如附件或請參考台灣技術交易資訊網（<https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx>）、及工研院研發成果公告網站（<https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1>）。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）107年11月23日14時整於工研院中興院區51館110-1室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於107年11月22日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「軟性電子、半導體光源及平面顯示器相關專利組合讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十三、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於107年11月22日下午 5 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日107年12月4日下午 5 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：



1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、廠商基本資料表（以下統稱「投標文件」），裝入信封密封之，並在信封上註明「軟性電子、半導體光源及平面顯示器相關專利組合讓與案投標」，於截標日 107 年 12 月 4 日下午 5 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 林小姐 收

2. 本標案採「專利組合」方式投標，同一「專利組合」不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、重要事項：

請投標人注意：「共有標的」係與第三人共有。「共有標的」之讓與，須經共有人同意後，始生效力。

七、押標金：

1. 押標金為總投標金額之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明收款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

八、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

九、決標方法：

1. 開標日為 107 年 12 月 6 日（開標時間及地點另行通知投標廠商）。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。



3. 同一「專利組合」以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一「專利組合」有二家(含)以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。
4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果(不公告得標廠商)。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

十、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期末與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經工研院同意者，不在此限)；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定(包括但不限於介入權、境外實施等規定)。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與標的」中之科專成果之讓與，須報經濟部同意後始生效；「讓與標的」中之「共有標的」之讓與，須經共有人同意。工研院對於共有人及經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：1.工研院已與第三人簽訂之授權契約；2.工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.工研院已承諾不會對特定之人行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專



屬授權或讓與時亦同。

10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。
11. 「讓與標的」之讓與登記手續由得標廠商負責辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商且應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部技術處，以下同)及立法院經濟委員會為境外實施等一切必要之申請(包括但不限於境外實施之申請等)，並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院及/或主管機關及/或立法院經濟委員會核准及同意後始得為之：
 - (1) 得標廠商在我國管轄區域(係指台、澎、金、馬，下同)外自行使用、實施者；
 - (2) 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；
 - (3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用；



(4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

13. 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得終止「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」中之科專成果收歸國有：

(1) 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」中之科專成果，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

(2) 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」中之科專成果者。

(3) 為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。

15. 得標廠商應使所有「後手」遵守十、契約事項第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 14 項、及第 16 項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

16. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對依中華民國法律設立之法人或中華民國國民就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

十一、領標方式：有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十三、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十二、注意事項：本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十三、聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 林小姐

電話：(03) 591-6636，傳真：(03) 582-0466，電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室



附件：讓與標的清單（7組專利組合，共45案110件專利）

組合編號	組合名稱	案編號	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請號/ 專利證號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	獨有/ 共有
組合 1	單音腔 結構之揚聲器 單元 (6案 14件)	P51960065	P51960065TW	揚聲器單體 結構	獲證	中華民國	I330500	2010 0911	2027 0903	科專	獨有
			P51960065CN		獲證	中國大陸	ZL200710184913.3	2013 0320	2027 1028	科專	獨有
			P51960065US		獲證	美國	8,107,651	2012 0131	2030 1015	科專	獨有
		P51960066	P51960066TW	靜電式揚聲器 結構與其 製造方法	獲證	中華民國	I340602	2011 0411	2027 0905	科專	獨有
			P51960066US		獲證	美國	8,155,356	2012 0410	2030 1220	科專	獨有
		P51960167	P51960167TW	可撓曲電聲 組合結構、 揚聲器及該 組件製造方法	獲證	中華民國	I330501	2010 0911	2028 0604	科專	獨有
			P51960167US		獲證	美國	8,138,034	2012 0320	2030 1207	科專	獨有
		P51970027	P51970027TW	揚聲器	獲證	中華民國	I376964	2012 1111	2028 0911	科專	獨有
			P51970027CN		獲證	中國大陸	ZL200810166128.X	2013 0807	2028 1007	科專	獨有
			P51970027US		獲證	美國	8,300,859	2012 1030	2031 0703	科專	獨有
		P51980009	P51980009US	靜電式揚聲器	獲證	美國	8,594,349	2013 1126	2032 0926	科專	獨有
		P51980022	P51980022TW	揚聲器的製 造方法與裝 置	獲證	中華民國	I419577	2013 1211	2029 1222	科專	獨有
			P51980022CN		獲證	中國大陸	ZL200910266096.5	2013 1106	2029 1230	科專	獨有
			P51980022US		獲證	美國	8,322,018	2012 1204	2030 0721	科專	獨有
組合 2	多音腔 結構之揚聲器 單元 (8案 20件)	P51950201	P51950201TW	靜電電聲轉 換器	獲證	中華民國	I331881	2010 1011	2027 1126	科專	獨有
			P51950201CN		獲證	中國大陸	ZL200710160549.7	2012 1114	2027 1224	科專	獨有
			P51950201US		獲證	美國	8,081,784	2011 1220	2030 1018	科專	獨有
		P51970025	P51970025TW	揚聲器單體 結構	獲證	中華民國	I367034	2012 0621	2028 0731	科專	獨有
			P51970025CN		獲證	中國大陸	ZL200810211084.8	2013 0123	2028 0819	科專	獨有
			P51970025US		獲證	美國	8,139,794	2012 0320	2030 0807	科專	獨有
		P51970026	P51970026TW	揚聲器的製 造方法	獲證	中華民國	I352547	2011 1111	2029 0406	科專	獨有
			P51970026CN		獲證	中國大陸	ZL200910141110.9	2013 1016	2029 0521	科專	獨有
			P51970026US		獲證	美國	8,196,282	2012 0612	2029 1122	科專	獨有
		P51970047	P51970047TW	駐極體揚聲器 單體的電	獲證	中華民國	I368445	2012 0711	2028 0810	科專	獨有



組合編號	組合名稱	案編號	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請號/專利證號	專利起期	專利迄期	科專/自有	獨有/共有		
			P51970047CN	極連接結構	獲證	中國大陸	ZL200810212834.3	20130206	20280904	科專	獨有		
			P51970047US		獲證	美國	8,280,081	20121002	20310211	科專	獨有		
		P51970126	P51970126TW	多面向平面式揚聲器裝置	獲證	中華民國	I399987	20130621	20290212	科專	獨有		
			P51970126US		獲證	美國	8,126,189	20120228	20300331	科專	獨有		
		P51970157	P51970157TWC1	平面揚聲器單體與揚聲器裝置	獲證	中華民國	I342165	20110511	20290524	科專	獨有		
			P51970157CN		獲證	中國大陸	ZL200910202828.4	20130403	20290525	科專	獨有		
			P51970157US		獲證	美國	8,391,520	20130305	20311215	科專	獨有		
		P51980010	P51980010TW	平面揚聲器結構	獲證	中華民國	I343756	20110611	20290809	科專	獨有		
			P51980010US		獲證	美國	8,385,586	20130226	20310615	科專	獨有		
		P51990077	P51990077US	平面揚聲器單體及平面揚聲器裝置	獲證	美國	8,625,824	20140107	20290225	科專	獨有		
		組合 3	投射式電容觸控感應器 (3案6件)	P51010101	P51010101TW	觸控結構及其製造方法	獲證	中華民國	I494801	20150801	20321129	科專	獨有
				P51990129	P51990129TW	軟性投射式電容觸控感應器結構	獲證	中華民國	I424348	20140121	20301230	科專	獨有
P51990129CN	獲證				中國大陸		ZL201110038779.2	20140730	20310213	科專	獨有		
P51990129US	獲證				美國		8,717,330	20140506	20320827	科專	獨有		
P51990131	P51990131CN			投射式電容觸控感應器結構及其製造方法	獲證	中國大陸	ZL201110234263.5	20150513	20310811	科專	獨有		
	P51990131US				獲證	美國	8,450,628	20130528	20320102	科專	獨有		
組合 4	GaN on Si 基板技術 (12案18件)	P51000005	P51000005CN	具有雙面場板的晶體管元件及其製造方法	獲證	中國大陸	ZL201110228914.X	20150701	20310809	科專	獨有		
		P51000114	P51000114TW	增強模式氮化物異質場效電晶體元件及其製造方法	獲證	中華民國	I538056	20160611	20311229	科專	獨有		
		P51000116	P51000116TW	氮化物半導體結構及其製造方法	獲證	中華民國	I460855	20141111	20311220	自有	獨有		
		P51000165	P51000165TW	氮化物半導體結構	獲證	中華民國	I482314	20150421	20321220	科專	獨有		
			P51000165CN		獲證	中國大陸	ZL201310057224.1	20160914	20330221	科專	獨有		
P51000165US	獲證		美國		8,946,775	2015	2032	科專	獨有				



組合編號	組合名稱	案編號	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請號/ 專利證號	專利 起期	專利 迄期	科專/ 自有	獨有/ 共有
								0203	1013		
		P51010062	P51010062TW	氮化物半導體結構	獲證	中華民國	I482276	2015 0421	2032 1011	科專	獨有
		P51010090	P51010090TW	氮化物半導體結構	獲證	中華民國	I491068	2015 0701	2032 1107	科專	獨有
			P51010090US		獲證	美國	8,779,468	2014 0715	2033 0113	科專	獨有
		P51020017	P51020017US	氮化物半導體結構	獲證	美國	9,159,788	2015 1013	2033 1230	科專	獨有
		P51020033	P51020033TW	氮化物半導體結構	獲證	中華民國	I565094	2017 0101	2033 1105	科專	獨有
		P51020042	P51020042US	氮化物半導體結構	獲證	美國	9,112,077	2015 0818	2034 0427	科專	獨有
		P51960152	P51960152TW	氮化物半導體層基板與氮化物半導體層之形成方法	獲證	中華民國	I375983	2012 1101	2028 0501	科專	獨有
			P51960152US		獲證	美國	8,221,547	2012 0717	2031 0516	科專	獨有
		P51990123	P51990123TW	氮化物半導體結構及其製造方法	獲證	中華民國	I416723	2013 1121	2030 1226	科專	獨有
		P51990125	P51990125TW	氮化物半導體基板及其製造方法	獲證	中華民國	I412069	2013 1011	2030 1226	科專	獨有
			P51990125CN		獲證	中國大陸	ZL201110395031.8	2014 0716	2031 1127	科專	獨有
			P51990125US		獲證	美國	8,604,487	2013 1210	2031 1218	科專	獨有
		組合 5	UV LED 磊晶與封裝 (9 案 22 件)	P08930115	P08930115TW	發光二極管	獲證	中華民國	I245440	2008 0625	2025 0113
P08930115CN	獲證				中國大陸		ZL200510002199.2	2005 1211	2024 1229	科專	獨有
P51000017	P51000017TW			發光二極體	獲證	中華民國	I466323	2014 1221	2031 1106	科專	獨有
	P51000017CN				獲證	中國大陸	ZL201110429567.7	2015 1216	2031 1219	科專	獨有
	P51000017US				獲證	美國	8,604,488	2013 1210	2032 0526	科專	獨有
P51000098	P51000098TW			發光二極體封裝結構	獲證	中華民國	I514630	2015 1221	2031 1229	科專	獨有
P51000160	P51000160TWC1			發光二極體	獲證	中華民國	I549317	2016 0911	2033 0130	科專	獨有
	P51000160CNC1				獲證	中國大陸	ZL201310061155.1	2016 0803	2033 0226	科專	獨有
	P51000160CND1				獲證	中國大陸	ZL201510547355.7	2018 0612	2033 0226	科專	獨有
P51010041	P51010041TW			發光二極體	獲證	中華民國	I499081	2015 0901	2032 1011	科專	獨有
	P51010041USD1	獲證	美國		9,680,051	2017 0613	2032 1116	科專	獨有		



工業技術研究院

Industrial Technology
Research Institute

組合編號	組合名稱	案編號	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請號/ 專利證號	專利起期	專利迄期	科專/ 自有	獨有/ 共有
組合 6	智慧照明技術 (3案 19件)	P51010174	P51010174TW	發光二極體	獲證	中華民國	I518942	2016 0121	2033 1114	科專	獨有
			P51010174CN		獲證	中國大陸	ZL201310571866.3	2018 0102	2033 1114	科專	獨有
			P51010174US		獲證	美國	8,952,411	2015 0210	2033 1114	科專	獨有
			P51010174USD1		獲證	美國	9,397,281	2016 0719	2033 1114	科專	獨有
		P51020015	P51020015US	發光二極管	獲證	美國	9,048,389	2015 0602	2033 1017	科專	獨有
		P51040025	P51040025TW	三五族氮化物半導體元件	獲證	中華民國	I568014	2017 0121	2035 1006	科專	獨有
		P51970144	P51970144TW	發光二極體 封裝結構	獲證	中華民國	I413284	2013 1021	2029 0223	科專	獨有
			P51970144TWD1		獲證	中華民國	I469402	2015 0111	2029 0223	科專	獨有
			P51970144CN		獲證	中國大陸	ZL200910132740.X	2012 0808	2029 0415	科專	獨有
			P51970144US		獲證	美國	8,178,890	2012 0515	2030 0216	科專	獨有
			P51970144USC1		獲證	美國	8,692,274	2014 0408	2029 1007	科專	獨有
		P51010099	P51010099TW	光源裝置	獲證	中華民國	I576010	2017 0321	2032 1227	科專	獨有
			P51010099TWC1	光源裝置及顯示裝置	申請中	中華民國	107121837			科專	獨有
			P51010099CN	光源裝置及照明裝置	獲證	中國大陸	ZL201310736811.3	2016 0706	2033 1226	科專	獨有
			P51010099CNC1	光源裝置及顯示裝置	申請中	中國大陸	201810672645.8			科專	獨有
			P51010099CND1	光源裝置及照明裝置	申請中	中國大陸	201610339601.4			科專	獨有
			P51010099US	光源裝置	獲證	美國	9,095,029	2015 0728	2034 0110	科專	獨有
			P51010099USC1	光源裝置	獲證	美國	9,693,408	2017 0627	2033 0415	科專	獨有
			P51010099USC2	光源裝置	獲證	美國	10,039,169	2018 0731	2033 0415	科專	獨有
P51010099USC3	光源裝置及顯示裝置		申請中	美國	16/018,086			科專	獨有		
P51030059	P51030059TW		照明系統以及使物體呈現目標視覺感受的方法	獲證	中華民國	I582331	2017 0511	2035 1119	科專	獨有	
	P51030059TWD1			獲證	中華民國	I626394	2018 0611	2035 1119	科專	獨有	
	P51030059US			獲證	美國	9,674,920	2017 0606	2035 1130	科專	獨有	
	P51030059USC1			獲證	美國	9,992,842	2018 0605	2035 1130	科專	獨有	
	P51030059USC2			獲證	美國	9,980,338	2018 0522	2035 1130	科專	獨有	



組合編號	組合名稱	案編號	件編號	中文專利名稱	狀態	國家	申請號/專利證號	專利起期	專利迄期	科專/自有	獨有/共有
		<u>P51990116</u>	P51990116TW	具有多功能用途的照明系統及其控制方法	獲證	中華民國	I545990	20160811	20310130	科專	獨有
			P51990116US		獲證	美國	8,847,508	20140930	20320807	科專	獨有
			P51990116USC1		獲證	美國	9,578,709	20170221	20310919	科專	獨有
			P51990116USC2		獲證	美國	9,900,956	20180220	20310919	科專	獨有
			P51990116USC3		申請中	美國	15/865,414			科專	獨有
組合 7	平面顯示器 (4案 11件)	P03920037	P03920037TW	可撓式面板之製作方法	獲證	中華民國	206791	20040621	20230827	科專	共有
			P03920037US		獲證	美國	7,147,531	20061212	20240421	科專	共有
			P03920037USD1		獲證	美國	7,297,040	20071120	20231029	科專	共有
		P03940069	P03940069TW	可撓式電晶體陣列基板的製造方法	獲證	中華民國	I265606	20061101	20250918	科專	共有
			P03940069US		獲證	美國	7,279,401	20071009	20260504	科專	共有
		P03930181	P03930181CN	薄膜晶體管的製作方法	獲證	中國大陸	ZL200510137737.9	20090701	20251218	科專	共有
			P03930181TW		獲證	中華民國	I290371	20071121	20251116	科專	共有
			P03930181US		獲證	美國	7,381,586	20080603	20260808	科專	共有
		P03930104	P03930104CN	用於倒置型有機發光組件的陰極結構	獲證	中國大陸	ZL200410084121.5	20081105	20241017	科專	共有
			P03930104TW		獲證	中華民國	I261483	20060901	20241014	科專	共有
			P03930104US		獲證	美國	7,307,380	20071211	20250426	科專	共有

【備註】：案編號加註雙底線者為非專屬授權中之專利；本公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之延續案、分割案、EPC 申請案指定國別後所包含之各國專利、PCT 同一案所申請之各國專利。